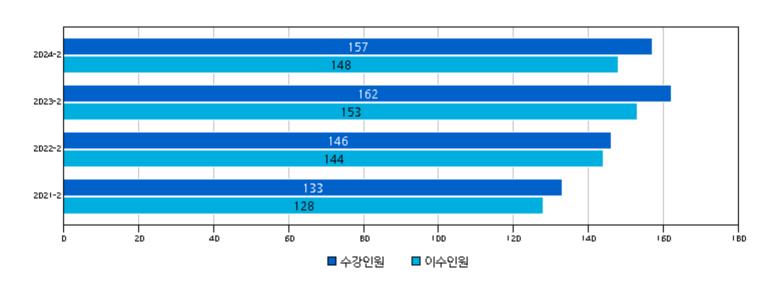
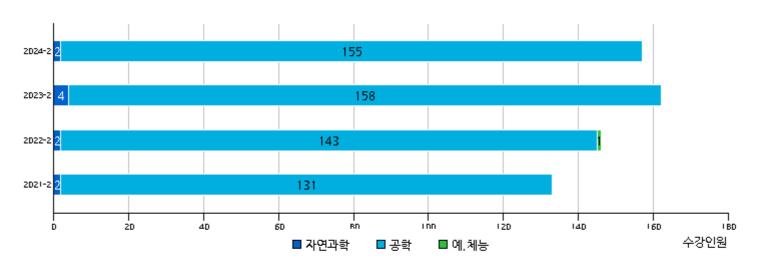
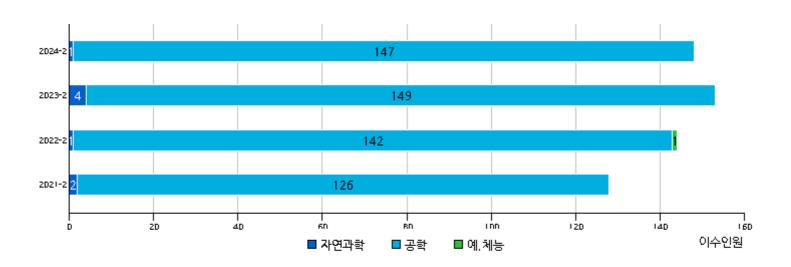
1. 교과목 수강인원



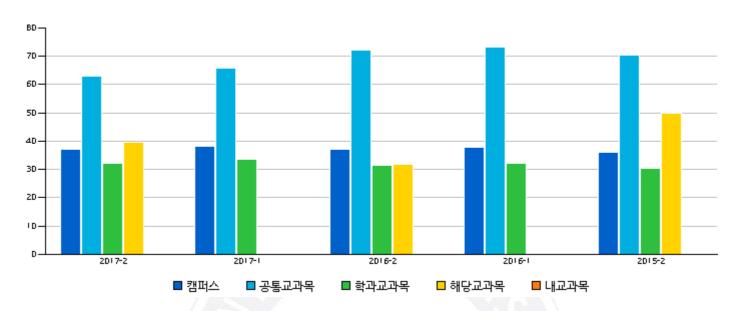




수업년도	수업학기	계열구분	수강인원	이수인원
2021	2	자연과학	2	2
2021	2	공학	131	126
2022	2	자연과학	2	1
2022	2	공학	143	142
2022	2	예,체능	1	1
2023	2	자연과학	4	4
2023	2	공학	158	149
2024	2	자연과학	2	1
2024	2	공학	155	147

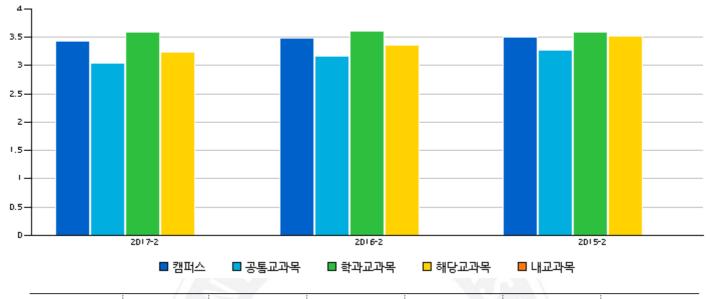


2. 평균 수강인원



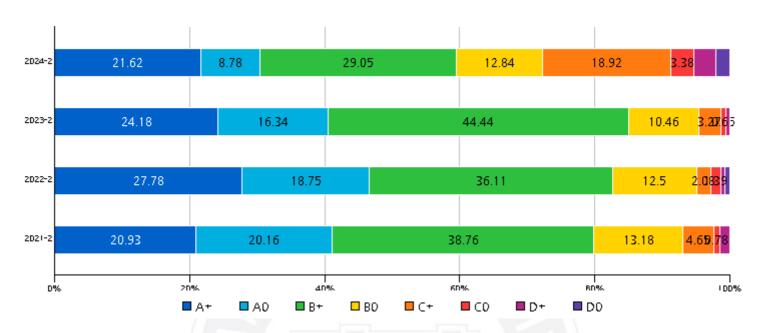
수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2017	2	37.26	63.09	32.32	39.5	
2017	1	38.26	65.82	33.5		
2016	2	37.24	72.07	31.53	32	
2016	1	37.88	73.25	32.17	1/2///	
2015	2	36.28	70.35	30.36	50	

3. 성적부여현황(평점)



수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2017	2	3.44	3.05	3.59	3.24	
2016	2	3.49	3.16	3.61	3.37	
2015	2	3.51	3.28	3.6	3.53	

4. 성적부여현황(등급)



수업년도	수업학기	등급	인원	비율	수업년도	수업학기	등급	인원	비율
2021	2	Α+	27	20.93	2023	2	C0	1	0.65
2021	2	Α0	26	20.16	2023	2	D+	1	0.65
2021	2	B+	50	38.76	2024	2	A+	32	21.62
2021	2	ВО	17	13.18	2024	2	A0	13	8.78
2021	2	C+	6	4.65	2024	2	B+	43	29.05
2021	2	C0	1	0.78	2024	2	ВО	19	12.84
2021	2	D+	2	1.55	2024	2	C+	28	18.92
2022	2	Α+	40	27.78	2024	2	C0	5	3.38
2022	2	Α0	27	18.75	2024	2	D+	5	3.38
2022	2	B+	52	36.11	2024	2	D0	3	2.03
2022	2	В0	18	12.5					

2.08

1.39

0.69

2022	2	2	D0	1	0.69
2023	3	2	Α+	37	24.18
2023	3	2	A0	25	16.34
2023	3	2	B+	68	44.44
		1		1	1

C+

C0

3

2

2022

2022

2022

2

2

2

5. 강의평가점수



수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2024	2	92.56	93.8	92.33	94	
2024	1	91.5	93.79	91.1		
2023	1	91.47	93.45	91.13		
2023	2	91.8	93.15	91.56	91	
2022	2	90.98	92.48	90.7	93	

6. 강의평가 문항별 현황

		본인평 균 (가중 치적용)	HOLE			점수별 인원분포				
번호	평가문항		소속학과,대학평균과의 차이 (+초과,-:미달)		매우 그렇 치않 다	그렇 치않 다	보통 이다	그렇 다	매우 그렇 다	
		5점	학과	C	내학	1 24	2 Z-l	그래	4점	디저
	교강사:	미만	차이 평균	· 차이	평균	· 1점	2점	3점	42	5점

No data have been found.

7. 개설학과 현황

학과	2025/2	2024/2	2023/2	2022/2	2021/2
융합전자공학부	3강좌(9학점)	3강좌(9학점)	3강좌(9학점)	3강좌(9학점)	2강좌(6학점)
반도체공학과	1강좌(3학점)	0강좌(0학점)	0강좌(0학점)	0강좌(0학점)	0강좌(0학점)

8. 강좌유형별 현황

강좌유형	2021/2	2022/2	2023/2	2024/2	2025/2
일반	2강좌(134)	3강좌(146)	3강좌(162)	3강좌(157)	0강좌(0)

9. 교과목개요

교육과정 관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2024 - 서울 공과대 2027 교육과 융합전자공 정 부	10 12 1 21 102 21 1	Method while VLSI Engineering consists of 2 phases, Design and Manufacturing ones Whether digital systems are high speed, high density and low power, CMOS technology find ubiquitous use in majory in the majority of leading edge commercial applications. MOSFET is clarified for giving the concept of basic electrical characterristics including AC and DC ones in CMOS Modern process in producing VLSI are concurrently undergoing with Design and Manufacturing so that a process technology of CMOS should be understood for more design optimization.	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
		념을 사용하여 동작속도와 회로면적,전력소비를 계산한다.Interconnection을 포함한 Wiring기 술을 통해 동작 속도를 계산한다 SPICE simulation 결과와 상기한 지연모델에 의한 결과를 서로 비교할수 있도록 한다 Digital회로에 사용되는 각종 회로 설계방법을 동작속도,면적,소비전력 측면에서 최적회로 설 계기법을 조합회로와 순서회로에 대해 적용한다 CAD Tool에관한 개념을 설명한다	wiring model in CMOS are given tfor the calculations. SPICE simulation is done for comparing with the above result All kind of CMOS circuit technologies are	
학부 2020 - 2023 교육과 정	서울 공과대학 융합전자공학 부	VLSI생산은 설계와 제조 의 2분야로 이루어진다본 과목에서는 주로 설계과정에 필요한 지식을 다룬다. VLSI설계의 최종목표는 처리속도고속화,고집적도,저전력을 갖는 회로를 구현하는데 있다CMOS회로 기술은 위에 기술한 최종목표를 달성할수 있는 회로기술로서 현재는 물론 장래 회로 구성 기본 소자로 널리 사용될 것이다본 강의에서는 CMOS에 대한 기본적인 전기적특성을 구하기 위해 MOSFET의 물리적 특성을 규명하고 CMOS에 대한 AC및 DC특성을 구한다.현대 VLSI생산과정은 설계와 제조를 동시에고려하여 최적화(낮은가격)하고 있으므로 제조과정을 이해할 필요성이 있다.따라서 본강의에서는 Process기술개요를 설명한다처리속도를 구하기 위해 설계단계에서 사용할수 있는 지연시간 모델과 Logical Effort라는 개념을 사용하여 동작속도와 회로면적,전력소비를계산한다.Interconnection을 포함한 Wiring기술을 통해 동작속도를계산한다 SPICE simulation 결과와 상기한 지연모델에의한 결과를서로비교할수 있도록한다 Digital회로에 사용되는 각종 회로 설계방법을 동작속도,면적,소비전력 측면에서 최적회로 설계기법을 조합회로와 순서회로에 대해 적용한다 CAD Tool에관한 개념을 설명한다	In this lecture we study VLSI Design Method while VLSI Engineering consists of 2 phases, Design and Manufacturing ones Whether digital systems are high speed, high density and low power, CMOS technology find ubiquitous use in majory in the majority of leading edge commercial applications. MOSFET is clarified for giving the concept of basic electrical characterristics including AC and DC ones in CMOS Modern process in producing VLSI are concurrently undergoing with Design and Manufacturing so that a process technology of CMOS should be understood for more design optimization. To calculate the operating speed, chip area and power consumption in CMOS, Logical Effort concept with a delayed model are used. Interconction and wiring model in CMOS are given tfor the calculations. SPICE simulation is done for comparing with the above result All kind of CMOS circuit technologies are surveyed in terms of operating speed, area and power consumption in the combinational and sequential logic c	
학부 2016 - 2019 교육과 정	서울 공과대학 융합전자공학 부	VLSI생산은 설계와 제조 의 2분야로 이루어진다 본 과목에서는 주로 설계과정에 필요한 지식을 다룬다. VLSI설계의 최종목표는 처리속도고속화,고집적 도,저전력을 갖는 회로를 구현하는데 있다 CMOS회로 기술은 위에 기술한 최종목표를 달 성할수 있는 회로기술로서 현재는 물론 장래 회 로 구성 기본 소자로 널리 사용될 것이다 본 강의에서는 CMOS에 대한 기본적인 전기적 특성을 구하기 위해 MOSFET의 물리적 특성을 규명하고 CMOS에 대한 AC및 DC특성을 구한 다.현대 VLSI생산과정은 설계와 제조를 동시에 고려하여 최적화(낮은가격)하고 있으므로 제조 과정을 이해 할 필요성이 있다.따라서 본강의에 서는 Process기술개요를 설명한다 처리속도를 구하기 위해 설계단계에서 사용할	In this lecture we study VLSI Design Method while VLSI Engineering consists of 2 phases, Design and Manufacturing ones Whether digital systems are high speed, high density and low power, CMOS technology find ubiquitous use in majory in the majority of leading edge commercial applications. MOSFET is clarified for giving the concept of basic electrical characterristics including AC and DC ones in CMOS Modern process in producing VLSI are concurrently undergoing with Design and Manufacturing so that a process technology of CMOS should be understood for more design optimization.	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
		수 있는 지연시간 모델과 Logical Effort라는 개 념을 사용하여 동작속도와 회로면적,전력소비를 계산한다.Interconnection을 포함한 Wiring기 술을 통해 동작 속도를 계산한다 SPICE simulation 결과와 상기한 지연모델에 의한 결과를 서로 비교할수 있도록 한다 Digital회로에 사용되는 각종 회로 설계방법을 동작속도,면적,소비전력 측면에서 최적회로 설 계기법을 조합회로와 순서회로에 대해 적용한다 CAD Tool에관한 개념을 설명한다	To calculate the operating speed, chip area and power consumption in CMOS, Logical Effort concept with a delayed model are used. Interconction and wiring model in CMOS are given tfor the calculations. SPICE simulation is done for comparing with the above result All kind of CMOS circuit technologies are surveyed in terms of operating speed, area and power consumption in the combinational and sequential logic c	
학부 2013 - 2015 교육과 정	서울 공과대학 융합전자공학 부	VLSI생산은 설계와 제조 의 2분야로 이루어진다 본 과목에서는 주로 설계과정에 필요한 지식을 다룬다. VLSI설계의 최종목표는 처리속도고속화,고집적 도,저전력을 갖는 회로를 구현하는데 있다 CMOS회로 기술은 위에 기술한 최종목표를 달 성할수 있는 회로기술로서 현재는 물론 장래 회 로 구성 기본 소자로 널리 사용될 것이다 본 강의에서는 CMOS에 대한 기본적인 전기적 특성을 구하기 위해 MOSFET의 물리적 특성을 규명하고 CMOS에 대한 AC및 DC특성을 구한 다.현대 VLSI생산과정은 설계와 제조를 동시에 고려하여 최적화(낮은가격)하고 있으므로 제조 과정을 이해 할 필요성이 있다.따라서 본강의에 서는 Process기술개요를 설명한다 처리속도를 구하기 위해 설계단계에서 사용할 수 있는 지연시간 모델과 Logical Effort라는 개 념을 사용하여 동작속도와 회로면적,전력소비를 계산한다.Interconnection을 포함한 Wiring기 술을 통해 동작 속도를 계산한다 SPICE simulation 결과와 상기한 지연모델에 의한 결과를 서로 비교할수 있도록 한다 Digital회로에 사용되는 각종 회로 설계방법을 동작속도,면적,소비전력 측면에서 최적회로 설 계기법을 조합회로와 순서회로에 대해 적용한다 CAD Tool에관한 개념을 설명한다	2 phases, Design and Manufacturing ones Whether digital systems are high speed, high density and low power, CMOS technology find ubiquitous use in majory in the majority of leading edge commercial applications. MOSFET is clarified for giving the concept of basic electrical characterristics including AC and DC ones in CMOS Modern process in producing VLSI are concurrently undergoing with Design and Manufacturing so that a process technology of CMOS should be understood for more design optimization. To calculate the operating speed, chip area and power consumption in CMOS, Logical Effort concept with a delayed model are used. Interconction and wiring model in CMOS are given tfor the calculations. SPICE simulation is done for comparing with the above result All kind of CMOS circuit technologies are	
학부 2009 - 2012 교육과 정	서울 공과대학 융합전자공학 부	VLSI생산은 설계와 제조 의 2분야로 이루어진다 본 과목에서는 주로 설계과정에 필요한 지식을 다룬다. VLSI설계의 최종목표는 처리속도고속화,고집적 도,저전력을 갖는 회로를 구현하는데 있다 CMOS회로 기술은 위에 기술한 최종목표를 달 성할수 있는 회로기술로서 현재는 물론 장래 회 로 구성 기본 소자로 널리 사용될 것이다 본 강의에서는 CMOS에 대한 기본적인 전기적 특성을 구하기 위해 MOSFET의 물리적 특성을 규명하고 CMOS에 대한 AC및 DC특성을 구한 다.현대 VLSI생산과정은 설계와 제조를 동시에 고려하여 최적화(낮은가격)하고 있으므로 제조 과정을 이해 할 필요성이 있다.따라서 본강의에 서는 Process기술개요를 설명한다	In this lecture we study VLSI Design Method while VLSI Engineering consists of 2 phases, Design and Manufacturing ones Whether digital systems are high speed, high density and low power, CMOS technology find ubiquitous use in majory in the majority of leading edge commercial applications. MOSFET is clarified for giving the concept of basic electrical characterristics including AC and DC ones in CMOS Modern process in producing VLSI are concurrently undergoing with Design and Manufacturing so that a process technology of CMOS should be	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
		처리속도를 구하기 위해 설계단계에서 사용할 수 있는 지연시간 모델과 Logical Effort라는 개 념을 사용하여 동작속도와 회로면적,전력소비를 계산한다.Interconnection을 포함한 Wiring기 술을 통해 동작 속도를 계산한다 SPICE simulation 결과와 상기한 지연모델에 의한 결과를 서로 비교할수 있도록 한다 Digital회로에 사용되는 각종 회로 설계방법을 동작속도,면적,소비전력 측면에서 최적회로 설 계기법을 조합회로와 순서회로에 대해 적용한다 CAD Tool에관한 개념을 설명한다	Effort concept with a delayed model are used. Interconction and wiring model in CMOS are given tfor the calculations. SPICE simulation is done for comparing with the above result All kind of CMOS circuit technologies are	

10. CQI 등록내역
No data have been found.
No data flave been found.